

2022年度 半導体エレクトロニクス部門委員会 第1回研究会

主催：日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会

期日：2022年8月6日（土） 13:00～15:35

会場：オンライン開催（担当：和歌山大学）

発表形式：基調講演 □頭発表 30分（質疑応答込）

一般公演 □頭発表 20分/件（質疑応答込）

プログラム：

[座長：宇野和行（和歌山大学）]

13:00～13:05 オープニング：喜多隆（半導体エレクトロニクス部門委員会 委員長）

13:05～13:35 基調講演「ドラッグデリバリーシステムに向けたセラソームの電子状態計算」
小田 将人 講師（和歌山大学）

～15分休憩～

[座長：宇野和行（和歌山大学）]

13:50～15:35 一般講演

13:50～14:10 ①「RF-MBE法を用いたGa_N成長に対するGa_N自立基板の微小オフ角依存性」

◇榊原 匠海¹, 出浦 桃子², 毛利 真一郎¹, 荒木 努¹

¹立命館大学理工学部, ²R-GIRO

14:10～14:30 ②「RF-MBE成長DERI法におけるIn_Nの初期成長機構」

○山田 泰弘¹, 中村 亮佑¹, 後藤 直樹¹, 毛利 真一郎¹, 出浦 桃子²,
荒木 努¹

¹立命館大理工, ²R-GIRO

14:30～14:50 ③「非極性p型ZnMgO:N薄膜のMBE成長」

◇萩原 綱隆, 後藤 憲應, 兵頭 歩, 込堂 大, 阿部 友紀, 市野 邦男,
赤岩 和明

鳥取大学

14:50～15:10 ④「高温アニール処理によるEu₂O₃共添加Ga_N中Euの周辺局所構造変化とEu赤色発光の高効率化」

◇岩谷 孟学¹, 市川 修平^{1,2}, Dolf Timmerman¹, 舘林 潤¹, 藤原 康文¹

¹大阪大学工学研究科, ²大阪大学超高压電子顕微鏡センター

15:10~15:30 ⑤ 「Si₃N₄メタサーフェス導入によるInGaN発光波長域での円偏光動作実証」
◇村田 雄生¹, 戸田 晋太郎^{1,3}, 藤原 康文¹, 中川 貴¹, 市川 修平^{1,2}
¹阪大院工, ²阪大超高圧電顕センター, ³アルバック協働研

15:30~15:35 クロージング

◇：「学生優秀講演賞」応募講演